# 物理学报 Acta Physica Sinica



时效Ag-7wt.%Cu合金的微观组织、电阻率和硬度

李蕊 左小伟 王恩刚

Microstructure, resistivity, and hardness of aged Ag-7wt.%Cu alloy

Li Rui Zuo Xiao-Wei Wang En-Gang

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 66, 027401 (2017) DOI: 10.7498/aps.66.027401 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.027401 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2017/V66/I2

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

#### 基于 AZO/VO<sub>2</sub>/AZO 结构的电压诱导相变红外光调制器

Infrared modulator based on AZO/VO $_2$ /AZO sandwiched structure due to electric field induced phase transition

物理学报.2016, 65(24): 248102 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.248102

基于 FTO/VO<sub>2</sub>/FTO 结构的 VO<sub>2</sub> 薄膜电压诱导相变光调制特性

Optical modulation characteristics of  $VO_2$  thin film due to electric field induced phase transition in the FTO/VO<sub>2</sub>/FTO structure

物理学报.2015, 64(19): 198101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.198101

VO<sub>2</sub>/AZO复合薄膜的制备及其光电特性研究

Fabrication and optical-electrical properties of VO2/AZO composite films物理学报.2014, 63(21): 218101http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.218101

 $Ba_{1-x}K_xFe_2As_2$ 单晶 ( $T_c$ =38.5K) 磁通钉扎力与钉扎机理研究 Investigation on the flux pinning force and flux pinning mechanism in  $Ba_{1-x}K_xFe_2As_2$  single crystal with  $T_c$  = 38.5 K

物理学报.2015, 64(11): 117401 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.117401

辅助永磁体磁化方式对单畴GdBCO超导块材捕获磁场分布及其磁悬浮力的影响

The effect of additional permanent magnet magnetizing methods on magnetic field distribution and the levitation force of single domain GdBCO bulk superconductor

物理学报.2013, 62(22): 227401 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.227401

# 时效Ag-7wt.%Cu合金的微观组织、 电阻率和硬度\*

李蕊<sup>1)2)</sup> 左小伟<sup>1)3)</sup> 王恩刚<sup>1)3)†</sup>

(东北大学,材料电磁过程研究教育部重点实验室,沈阳 110819)
 2)(东北大学材料科学与工程学院,沈阳 110819)
 3)(东北大学冶金学院,沈阳 110819)

(2016年9月19日收到;2016年10月16日收到修改稿)

采用差示扫描量热法、X射线衍射及透射电子显微镜研究了固溶和固溶-冷轧Ag-7wt.%Cu合金在时效 过程中富Cu相的析出动力学和形貌特征,同时结合电阻率和显微硬度的测量,定量对比了固溶和固溶-冷轧 Ag-7wt.%Cu合金时效过程中富Cu相对电阻率和硬度的影响及其机理.研究结果表明:固溶样品中富Cu相 反应温度为300°C—350°C,析出激活能为(111±1.6) kJ/mol;而固溶-冷轧样品中由于形变能的存在,富 Cu相温度降低为290°C—330°C,析出激活能升高为(128±12) kJ/mol. XRD结果证实富Cu相的析出过 程与时效温度有关.固溶和固溶-冷轧合金在450°C时效后均能观察到球状的富Cu相,富Cu相的析出和溶 解过程对电阻率和显微硬度有显著影响.当时效温度低于450°C时,随时效温度的提高,固溶-时效样品的 电阻率降低,显微硬度增加;而固溶-冷轧-时效样品的电阻率和显微硬度均逐渐降低.显微硬度除了受富Cu 相的影响外,还受到位错和形变孪晶的影响.当时效温度高于450°C时,两种样品的电阻率增大,而显微硬 度降低.

关键词: Ag-Cu 合金, 显微组织, 电阻率, 显微硬度 PACS: 74.25.-q, 81.05.-t

#### **DOI:** 10.7498/aps.66.027401

# 1引言

Ag-Cu合金被用于制造各种工艺品、银器等<sup>[1,2]</sup>,同时由于具有优良的机械性能和导电性能被广泛用于高强度高导电材料<sup>[3,4]</sup>.根据Ag-Cu合金平衡相图<sup>[5]</sup>,779.1°C共晶温度时Cu在Ag中的最大固溶度为8.27wt.%,室温时Cu在Ag中的最大固溶度不超过1wt.%,且室温时Ag-7wt.%Cu合金由富Ag相和富Cu相组成,这使得Ag-7wt.%Cu合金在高温淬水冷却后能够形成亚稳的过饱和固溶体,通过时效热处理,使Cu在Ag中的固溶度降低,形成富Cu相,在降低合金电阻率的同时,强化

Ag基体<sup>[6]</sup>.因此,研究Ag-Cu合金中富Cu相的析 出行为尤为重要.

固溶Ag-8wt.%Cu合金中富Cu相的析出行为 研究表明,Cu的析出温度在290°C—392°C<sup>[7]</sup>,多 晶Ag合金时效处理时富Cu相呈类似于珠光体型 片层形貌;而单晶Ag合金时效处理时富Cu相呈 晶面型<sup>[8]</sup>;合金固溶体中的析出过程由界面扩散 控制<sup>[9]</sup>,在高过饱和度、低时效温度下,Cu为不 连续性析出,而在低过饱和度、高时效温度下富 Cu相是连续的<sup>[10]</sup>,固溶合金的相对电阻随时效 温度的增加而增加,达到一个最大值后下降,分析 认为它的变化由富Cu相-空位团簇的形成和长大 引起<sup>[11]</sup>.而针对形变Ag-Cu合金,Nada<sup>[12]</sup>研究

\* 国家自然科学基金 (批准号: 51474066, 51004038) 和高等学校学科创新引智计划 (批准号: B07015) 资助的课题.

© 2017 中国物理学会 Chinese Physical Society

<sup>†</sup>通信作者. E-mail: egwang@mail.neu.edu.cn

了冷轧变形后 Ag-2wt.%Cu 合金的析出动力学,发现形变后 Ag-2wt.%Cu 合金的富 Cu 相的析出激活能为 22.1 kJ/mol. Wang 等<sup>[13]</sup>研究了大变形 Ag-10wt.%Cu 合金线材经过等温时效和等时时效后的组织演变及其性能,发现当时效温度高于 300 °C 后,发生再结晶和晶粒长大过程,导致形变过程中形成的连续 Cu 纤维逐渐转变成 Cu 颗粒,合金线材的强度降低,导电率升高.但以上的结果并未对比固溶和固溶-形变 Ag-Cu 合金在时效过程中富 Cu 相对两种不同处理状态合金的电阻率及显微硬度的影响规律,并且未定量探讨富 Cu 相对合金导电机理及强度机理的研究.

为了探讨固溶和固溶-冷轧的 Ag-Cu 合金在时 效过程中富 Cu 相对合金电阻率和显微硬度的不同 规律及其影响机理,本文通过高温淬水形成亚稳 态过饱和 Ag-7wt.%Cu 固溶体,同时对过饱和固溶 体进行冷轧变形,施加不同温度的时效处理.借助 X射线衍射 (XRD)确定时效过程中 Ag-7wt.%合金 富 Cu 相的分布,采用差式扫描量热法 (DSC)研究 了固溶和固溶-冷轧变形的 Ag-7wt.%Cu 合金在不 同温度的时效过程中富 Cu 相的析出与溶解动力 学,同时结合透射电子显微镜 (TEM)研究富 Cu 相 的微观形貌,并且定量计算对比了富 Cu 相对固溶 和固溶-冷轧 Ag-7wt.%Cu 合金的电阻率和显微硬 度的影响机理.

#### 2 实验方法

用纯度为99.99%的无氧铜和99.97%的电解 银棒按照质量分数进行配比,置于石墨坩埚中,在 真空状态下经ZR-2型中频感应熔炼炉熔炼后随炉 冷却,制成Ag-7wt.%Cu的母合金.将母合金置于 电阻炉中,在氩气保护下升温到760°C,保温2h后 淬水冷却,获得固溶处理样品.将一部分固溶处理 样品直接进行时效处理(SS-aged alloy),而另一部 分切割加工成80 mm×9.2 mm×8.7 mm(长×宽 × 高)的板状样品先进行冷轧,利用( $t_0 - t$ )/ $t_0$ 表 示冷轧样品的减面率,其中t表示冷轧后样品厚度,  $t_0$ 表示初始样品厚度,冷轧最终厚度为0.6 mm,减 面率为93%,并将冷轧样品进行时效处理(RS-aged alloy).时效温度为200°C—760°C,保温2h后, 随炉冷却. 在氮气保护下利用差示扫描量热法 (TA DSC-Q100) 测试固溶处理和冷轧后样品在100°C-550°C 升温过程中的热流变化,加热速率为10—50°C/min.采用X射线衍射仪 (D8 Discover) 测量样品的物相并分析固溶引起的晶格畸变.利用数字电阻仪 (Keithley 2450) 采用四点探针法测量样品在室温时的电阻率.用硬度测试仪 (SC 502) 测量样品的维氏硬度,加载载荷为100g,加载时间为10s.用带有能谱 (EDS) 的透射电镜 (FEI-Tecnai G<sup>2</sup> 20) 观察合金的微观组织形貌.

# 3 实验结果

#### 3.1 富Cu相的析出动力学

固溶处理Ag-7wt.%Cu合金在不同加热速率 下的DSC曲线(图1(a))表明,固溶处理后样品在 300°C—350°C之间有一个放热反应,这与前期富 Cu相的析出温度范围230°C—392°C的结果基本 符合<sup>[3]</sup>,因此我们推断此放热反应为富Cu相由Ag 基体内析出所引起.固溶-冷轧处理Ag-7wt.%Cu 合金在不同加热速率下的DSC曲线(图1(c))表 明,固溶-冷轧状态的样品在290°C—330°C之间 也存在一个放热反应,这是冷轧后Ag-7wt.%Cu合 金中富Cu相的析出所引起,并且放热反应温度范 围(290°C—330°C)略低于固溶处理后样品的反 应温度(300°C—350°C),这是由冷轧形变储能释 放所引起.

差热分析曲线中的峰值温度(图1)即富Cu相的析出峰值温度随加热速率(10°C—50°C/min)的增加向高温偏移,根据不同速率下的峰值温度,利用Kissinger模型<sup>[14]</sup>推算富Cu相的激活能E<sub>a</sub>:

$$\ln\left(\frac{v}{T_{\rm p}^2}\right) = \frac{-E_{\rm a}}{RT_{\rm p}} + C,\tag{1}$$

其中, v表示加热速率,  $T_p$ 是DSC曲线上的峰值温度,  $E_a$ 是激活能 (kJ/mol), 常数 $C = \ln \frac{AR}{E_a}$ , A是频率因子 (热力学反应中的分子碰撞频率), R是气体常数. 在Kissinger 拟合直线中, C表示直线的截距, 常数C是不依赖于温度的反应参数, 由截距可以求得频率因子 A.

基于 Kissinger 模型 中  $\ln(v/Tp^2)$  与 1000/ $T_p$ 之间的线性关系,估算出固溶处理后样品富 Cu 相 的析出反应激活能为 (111 ± 1.6) kJ/mol(图 1 (b)); 固溶-冷轧处理样品富Cu相析出反应激活能为 (128±12) kJ/mol(图1(d)),此值略高于固溶处理 样品的激活能(111±1.6) kJ/mol),这是因为形变 过程中产生大量位错和孪晶引起晶格畸变(下文微 观组织部分将介绍),产生形变储存能,在加热过程 中析出的富Cu相为了克服这一部分能量,导致富 Cu相的析出激活能升高.我们计算的固溶-冷轧 处理样品的激活能(128±12) kJ/mol也高于形变 Ag-2wt.%Cu合金的激活能(22.1 kJ/mol)<sup>[13]</sup>,这种差别由DSC仪器的误差、样品的测量重量(±1.5 mg)误差以及化学成分误差所引起<sup>[15,16]</sup>.对于固溶和固溶-冷轧Ag-7wt.%Cu合金,常数C的数值稍有变化,根据直线拟合的结果,固溶和固溶-冷轧Ag-7wt.%Cu合金的C值分别是12.66和16.81,前者C的数值较后者小,表明在固溶-冷轧样品中Cu析出时的分子碰撞频率更高.



图 1 Ag-7wt.%Cu 合金不同加热速率下的 DSC 曲线和 Kissinger 模型拟合曲线 Fig. 1. Differential scanning calorimetric curves of (a) solid-solution Ag-7wt.%Cu samples, and (c) coldrolled samples after water quenched with different heating rates from 10 °C/min to 50 °C/min, (b) and (d) showing the corresponding fitting curves of (a) and (c) between  $\ln(v/T_p^2)$  and  $1000/T_p$  based on Kissinger equation.

#### 3.2 微观组织

Ag-7wt.%Cu合金在760°C淬水后Ag基体中 无富Cu相(图2(a)), EDS结果(图2(b))显示淬水 后合金中的Cu元素质量百分比为6.84%, 与合金 的名义成分7wt.%相近. 经450°C时效处理后 Ag基体中发现存在三种形态的富Cu相: 1)带状 Cu相(图2(d)), 2)尺寸约为100 nm的球状富Cu 相, 3)细小的球状纳米富Cu相(图2(e)),这些细 小的富Cu相与Ag基体保持立方-立方晶体学关系 (图2(f)).带状富Cu相的产生是由于富Cu相在 界面前沿的过饱和层处周期性的形核,富Cu相降低了过饱和度,使得界面前沿生长加快,继而又形成新的过饱和层,为富Cu相的形核提供条件,因而循环往复形成了带状富Cu相<sup>[17]</sup>.球状富Cu相的产生,是因为淬水后Ag基体中存在空位等缺陷,在时效过程中,这些缺陷成为富Cu相的形核质点,随着时效过程的进行,形核后的富Cu相逐渐长大,最终形成尺寸较大的富Cu相.由于Cu在Ag基体内以连续析出方式形核长大,扩散系数较低(2.80×10<sup>-11</sup> cm<sup>2</sup>/s<sup>[9]</sup>),致使球状纳米富Cu相来不及长大而形成细小的纳米富Cu相.



图 2 固溶-时效 Ag-7wt.%Cu 合金中富 Cu 相的形貌及成分 (a) 淬水态; (b) 淬水态 Ag 基体的 EDS 结果; (c) 450 °C 时效后的带状富 Cu 相; (d) 450 °C 后球状富 Cu 相; (e) 450 °C 纳米富 Cu 相的明场相; (f) 450 °C 纳米富 Cu 相的选取衍射斑点

Fig. 2. Morphology and composition of SS-aged Ag-7wt.%Cu alloy: (a) As-solid-solution, (b) EDS result in Ag matrix; (c) banded Cu-rich phase, (d) spherical Cu-rich phase, (e) nano Cu-rich phase and (f) corresponding electron diffraction pattern of samples aged at 450  $^{\circ}$ C.

在固溶-冷轧变形 Ag-7wt.%Cu 合金中, Ag基体和富 Cu 相的形貌发生了改变. 黑色棒状的富 Cu 相周围存在大量位错胞(图3(a)),基体中形成大量的 Ag形变孪晶(图3(b)). 300°C时效退火后,退火孪晶 Ag的尺寸显著长大(图3(d)). 450°C时效退火后,由 Ag基体中析出的富 Cu 相尺寸约为 100 nm (图3(c)).

#### 3.3 晶格畸变及Cu在Ag中的固溶度

时效温度低于 350 °C时, X 射线衍射表明只有 富 Ag 固溶体, 当时效温度高于 300 °C时, 存在富 Ag固溶体和富Cu相(图4(b)).时效温度越高,富 Cu相的峰越尖锐,说明随着时效温度的升高,富 Cu相析出逐渐增多.固溶-冷轧-时效样品的规律 与固溶-时效样品规律类似(图5).因此,富Cu相 的析出与时效过程密切相关.

采用 Jade-6.0 软件分析 Ag-7wt.%Cu合金在 不同时效温度下 XRD曲线中Cu的(111)峰和 Cu(200)峰,获得峰值面积百分比,这两个峰值面 积百分比之和即为Cu在不同时效温度下的析出质 量百分数,以合金的实际质量分数减去Cu的质量 百分数,即可得到Cu在Ag基体中的固溶度.然后,



图 3 固溶 - 冷轧及固溶 - 冷轧 - 时效 Ag-7wt.%Cu 合金的 TEM 图像 (a) 富 Cu 相及位错胞; (b) Ag 的形变孪晶; (c) 时效 450 °C 样品的富 Cu 相; (d) 时效 300 °C 的退火孪晶

Fig. 3. TEM micrographs of cold-rolled and cold-rolled aged Ag-7wt.% Cu alloy: (a) Cu-rich phase morphology and dislocation cell; (b) deformation Ag-twins; (c) Cu-rich phase in aged samples at 450 °C; (d) annealing Ag twins in aged samples at 300 °C.



图 4 (a) 固溶 Ag-7wt.%Cu 合金在不同时效处理后的 XRD 结果及 (b) 时效温度 350 °C 和 450 °C 时合金样品的 Cu(111) 和 Cu(200) 峰局部放大图

Fig. 4. (a) XRD results of Ag-7wt.%Cu alloy at different ageing temperature and (b) high magnified image of Cu (111) and Cu (200) peak at 350 °C and 450 °C.

将Cu在Ag中的质量百分数转换成原子百分比, 即为固溶和固溶-冷轧Ag-7wt.%合金在不同时效 温度下Cu在Ag基体内的固溶度(表1). 计算得 出Cu在Ag中的固溶度结果如下:固溶淬水后, Cu在Ag基体内的固溶度为6.8wt.%,与前述EDS 测试结果6.84wt.%相近,时效温度为350°C和 450 °C时, Cu在Ag基体内的固溶度分别是1.4% 和0.2%. 固溶-冷轧后, Cu在Ag基体内的固溶度 为6.4wt.%, 此值比固溶淬水后Cu在Ag中的固溶 度6.8% 略低, 时效温度为350 °C和450 °C 时, Cu 在Ag 基体内的固溶度分别是0.8% 和0.1%.



图 5 固溶 - 冷轧 Ag-7wt.%Cu 合金不同时效温度下的 XRD 结果

Fig. 5. XRD results of cold-rolled Ag-7wt.%Cu alloy at different ageing temperatures.

表1 Ag-7wt.%Cu合金不同时效温度下Cu在Ag中的 固溶度

Table 1. The solubility of Cu in Ag in Ag-7wt.%Cu alloy at different ageing temperature.

| Ageing temperature $/^{\circ}C$ | SS-aged alloy<br>/wt.% | RS-aged alloy<br>/wt.% |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| No ageing treatment             | 6.8                    | 6.4                    |
| 200                             | 6.6                    | 5.9                    |
| 350                             | 1.4                    | 0.8                    |
| 450                             | 0.2                    | 0.1                    |
| 760                             | 5.0                    | 1.1                    |

#### 3.4 显微硬度与电阻率

时效温度为200°C时, Ag-7wt.%Cu合金的电 阻率略降低,显微硬度略升高(图6(a)).继续升 高时效温度, Ag-7wt.%Cu合金的电阻率继续降低, 显微硬度继续增大.时效温度为400°C—450°C 时,显微硬度呈现一个平台,硬度值达到150 HV 且几乎保持不变,这个硬度值与Sterling银(Ag-7wt.%Cu)合金的硬度值相近<sup>[18]</sup>.时效温度达到 450°C时,显微硬度增加了58%,电阻率降低了 30%,且达到最小值.时效温度高于450°C,电阻率 开始增大,显微硬度下降.



图 6 (a) 固溶和 (b) 固溶 -冷轧 Ag-7wt.%Cu 合金在不同 时效温度下的电阻率和显微硬度

Fig. 6. Resistivity and micro-hardness of Ag-7wt.%Cu alloy at different aging temperatures: (a) SS-aged;(b) RS-aged.

不同时效温度对固溶-冷轧Ag-7wt.%Cu合金 电阻率和显微硬度的影响如图6(b)所示,随时 效温度的升高,电阻率变化趋势与固溶-时效Ag-7wt.%Cu合金(图6(a))类似. 冷轧变形后的Ag-7wt.%Cu合金的显微硬度的变化规律与固溶-时效 Ag-7wt.%Cu合金(图6(a))的不同,硬度值在轧制 态达到最大值217 HV,随着时效温度升高,显微硬 度一直呈现下降的趋势.

# 4 分析讨论

#### 4.1 Ag-7wt.%Cu合金的性能

4.1.1 富Cu相对Ag-7wt.%Cu合金电阻率 的影响

合金的电阻率主要受界面散射、位错散射、 声子散射和杂质散射的影响.之前的研究结果表 明<sup>[19]</sup>, Ag-7.5wt.%Cu合金的电阻率主要来自固溶 于 Ag 基体内的 Cu产生杂质散射,因此,本实验主要研究 Ag-7wt.%Cu 合金中由固溶于 Ag 基体的 Cu 引起杂质散射而产生的电阻率. Ag-7wt.%Cu 合金的电阻率可以表示为<sup>[20]</sup>

$$\rho = \rho_0 + \Delta \rho_{\rm imp} = \rho_0 + \chi_{a,\rm Cu} \left[\frac{\Delta \rho}{a}\right], \qquad (2)$$

式中,  $\rho_0$  是合金基体的电阻率,  $\Delta \rho_{imp}$  是固溶原子 引起的电阻率,  $\chi_{\alpha,Cu}$  是富 Cu 相的原子分数,  $\Delta \rho/a$ 为单位原子引起的电阻率变化, 这里 Cu 在 Ag 中引 起的电阻率  $\Delta \rho/a = 0.68 \text{ n}\Omega \cdot \text{m/at.\%}^{[21]}$ .

合金基体电阻率可以根据合金基体中各相所 占体积分数确定.纯Ag 电阻率为 $\rho_{Ag}$ =1.559 μΩ·cm, 纯Cu的电阻率 $\rho_{Cu}$ =1.667 μΩ·cm<sup>[22]</sup>. Ag-7wt.%Cu 合金中Ag相所占体积分数为91.84%,富Cu 相 所占体积分数为8.16%,所以,根据混合定律Ag-7wt.%Cu合金基体电阻率 $\rho_0$ =1.58 μΩ·cm.

杂质散射引起的电阻率可以根据Cu在Ag 中固溶度的原子百分比(表2)计算,可知Ag7wt.%Cu 合金在760 °C固溶2 h淬水冷却后,  $\Delta \rho_{imp} \ge 0.75 \ \mu\Omega \cdot cm$ ,时效温度升高至450 °C,Cu 在Ag中的固溶度最小,此时 $\Delta \rho_{imp} \ge 0.02 \ \mu\Omega \cdot cm$ .

表2给出了各因素引起的Ag-7wt.%Cu合金电 阻率的变化情况,计算值ρ比实际测量值ρ<sub>M</sub>小,这 可能是由于计算中忽略了晶界散射和空位散射. 表2中电阻率的计算值和测量值的趋势符合.因此,Cu在Ag基体中的析出和溶解是影响电阻率的 主要因素.固溶于Ag中的Cu原子增多,自由电子 在传输过程中由于固溶散射作用增加,导致固溶淬 水的Ag-7wt.%Cu合金样品电阻率最大.当时效温 度升高至300°C时,富Cu相开始析出,降低了自 由电子在传输过程中由于固溶散射的作用,导致合 金的电阻率降低.时效温度达到450°C时,Cu在 Ag中的固溶度最小,对自由电子传输过程中的散 射作用最小,所以合金的电阻率在450°C最小.进 一步升高时效温度至500°C—760°C后,富Cu相 开始重新溶解于Ag基体中,导致电阻率重新增大.

表 2 固溶 -时效和固溶 -冷轧 -时效 Ag-7wt.%Cu 合金的电阻率的计算值和测量值

| <b>T</b> 1 1 0 | a 1 1 1 1  |     |          |            |               |    | aa 1    |     | Da 1    |         | $\sim$ | a 11   |       |
|----------------|------------|-----|----------|------------|---------------|----|---------|-----|---------|---------|--------|--------|-------|
| Table 2.       | Calculated | and | measured | electrical | resistivities | in | SS-aged | and | RS-aged | Ag-7wt. | %      | Cu all | lovs. |

| SS-aged alloy             |   |       |   |  |   |  |  |  |
|---------------------------|---|-------|---|--|---|--|--|--|
| Ageing temperature<br>/°C | $ \begin{array}{c} \text{temperature} \\ /^{\circ}\text{C} \end{array} \begin{array}{c} \text{Resistivity of} \\ \text{Ag matrix } \rho_0 \\ /\mu\Omega\cdot\text{cm} \end{array} \end{array} $ |       | Resistivity of Cu<br>precipitate<br>$\Delta \rho_{imp}/\mu \Omega \cdot cm$ | Total resistivity $\rho/\mu\Omega\cdot cm$ | Measured data $\rho_{\rm M}/\mu\Omega\cdot{\rm cm}$ |  |  |  |
| No ageing                 | 1.58  | 11.04 | 0.75  | 2.33                                       | 2.68  |  |  |  |
| 200                       | 1.58  | 10.73 | 0.73  | 2.31                                       | 2.61  |  |  |  |
| 350                       | 1.58  | 2.36  | 0.16  | 1.74                                       | 2.43  |  |  |  |
| 450                       | 1.58  | 0.34  | 0.02  | 1.60                                       | 1.91  |  |  |  |
| 760                       | 1.58 8.22   |       | 0.56  | 2.14                                       | 2.33  |  |  |  |
| RS-aged alloy             |   |       |   |  |   |  |  |  |
| No ageing                 | 1.58  | 10.42 | 0.71  | 2.29                                       | 2.91  |  |  |  |
| 200                       | 1.58  | 9.64  | 0.66  | 2.24                                       | 2.56  |  |  |  |
| 350                       | 1.58  | 1.35  | 0.09  | 1.67                                       | 2.05  |  |  |  |
| 450                       | 1.58  | 0.17  | 0.01  | 1.59                                       | 1.97  |  |  |  |
| 760                       | 1.58  | 1.86  | 0.13  | 1.71                                       | 2.21  |  |  |  |

# 4.1.2 富 Cu 相对 Ag-7wt.%Cu 合金显微硬度 的影响

时效硬化的Ag-Cu合金的强化机制主要来 自于固溶强化( $H_{ss}$ )、析出强化( $\Delta H_{p}$ )、晶界强 化( $\Delta H_{GB}$ )和位错强化( $H_{D}$ )的综合作用. Ag-7wt.%Cu合金的硬度可以表示为<sup>[23]</sup>  $\Delta H V_{\text{Total}}$   $= H V_0 + \Delta H V_{\text{SS}}$   $+ (\Delta H V_{\text{GB}}^n + \Delta H V_{\text{D}}^n + \Delta H V_{\text{P}}^n)^{1/n}, \quad (3)$ 

式中, n是常数, 其值为1—2, 这里选择<sup>[23]</sup> n = 1, HV<sub>0</sub>是纯银的硬度, 其值是 48 HV<sup>[24]</sup>.

固溶强化  $\tau_{\rm ss}$  可以表示为<sup>[25]</sup>  $\Delta \tau_{\rm SS} = G\left((\delta) + \frac{1}{20}|\eta|\right)^{3/2} \sqrt{\chi_{\alpha,\rm Cu}/3}, \quad (4)$ 

式中, *G*是 Ag 基体的剪切模量, 为29.4 GPa<sup>[26]</sup>,  $\delta$ 是晶格变化常数,  $\eta$ 是由于 Cu 溶于 Ag 引起的剪 切模量改变<sup>[25]</sup>.本实验中忽略 Cu 原子溶于 Ag 引 起的剪切模量改变 $\eta$ , 根据文献 [25, 26] 计算出晶 格变化常数 $\delta = 0.0928$ , 所以由 (4) 式得固溶强化 公式为

$$\Delta \tau_{\rm SS} = 0.028 G \sqrt{\chi_{\alpha,\rm Cu}/3},\tag{5}$$

由此计算得出固溶 Ag-7wt.%Cu 合金的固溶强化 作用是 158 MPa, 450 °C 时效后的固溶强化作用是 27 MPa. 而固溶 -冷轧 Ag-7wt.%Cu 合金的固溶强 化作用是 89 MPa, 450 °C 时效后的固溶强化作用 是 20 MPa.

析出强化根据E.Orowan机制可以表示为<sup>[27]</sup>

$$\Delta \tau_{\rm P} = G \boldsymbol{b} / (l - 2r), \tag{6}$$

式中, G是Ag基体的剪切模量, 为29.4 GPa<sup>[26]</sup>, b是Ag的柏氏矢量, 其值是0.2887 nm, r是析出 相半径, l是析出相的间距, 固溶的Ag-7wt.%Cu 合金进行温度为450 °C/2 h的时效处理后, l和r 分别约是140和35 nm, 因此, 析出强化作用达到 121 MPa. 对于固溶-冷轧的Ag-7wt.%Cu合金进 行450 °C/2 h的时效处理后, l和r分别约是160和 40 nm, 计算得出固溶冷轧Ag-7wt.%Cu合金的富 Cu相的析出强化作用达到106 MPa.

当r≪l时, 析出强化表示为<sup>[27]</sup>

$$\Delta \tau_{\rm P} = G \boldsymbol{b} \sqrt{f/r},\tag{7}$$

式中, *f* 是析出相的体积分数. 固溶 Ag-7wt.%Cu 合金在进行 450 °C 时效后, 纳米的富 Cu 相半径 *r* 约为 10 nm, 析出相间距 *l* 约为 100 nm, 体积分数 *f* 约为 1.7%, 计算出纳米富 Cu 相的析出强化作用为 110 MPa.

晶界强化可以表示为[25]

$$\Delta \tau_{\rm HP} = k_{\rm HP} / \sqrt{d}, \qquad (8)$$

式中, d是平均晶粒尺寸,  $k_{HP}$ 是霍尔佩奇常数,  $k_{HP} = 0.15$  MPa. 由于我们所做的晶粒尺寸很大 (>200  $\mu$ m),所以晶界强化小于5 HV.

Hull和Bacon<sup>[28]</sup>建立了面心立方结构 (fcc)的 合金位错强化的模型<sup>[28]</sup>:

$$\Delta \tau_{\rm D} = BG \boldsymbol{b} \sqrt{N},\tag{9}$$

式中, *B*是常数, 对于 fcc 结构的金属, *B* = 0.2, *G* 是剪切模量, *b*是柏氏矢量, *N* 是位错密度.

位错密度N可以表示为<sup>[29]</sup>

$$N = \frac{3}{\pi} \left( \frac{\varepsilon}{0.244 \boldsymbol{b}} \right)^2 = 16.1 \frac{\varepsilon^2}{\boldsymbol{b}^2}, \qquad (10)$$

式中, *ε* 是微观应变, *b* 是柏氏矢量. *ε* 是由晶格畸 变和位错引起的, 可以通过衍射峰的半高峰宽表示 为<sup>[29]</sup>

$$\frac{\xi_{hkl}\cos\theta}{\lambda} = \frac{2\sin\theta}{\lambda}\varepsilon,\tag{11}$$

式中,  $\varepsilon \neq \frac{\xi_{hkl} \cos \theta}{\lambda} \frac{2 \sin \theta}{\lambda}$ 之间线性关系的斜率,  $\theta$ 是 Ag 衍射峰的 (*hkl*) 面对应的衍射角, 本文选择 Ag 衍射峰的 (111) 和 (200) 衍射面的衍射角,  $\lambda \neq \lambda$ 射 X 射线的波长  $\lambda = 0.15405$  nm.

其中, ξ<sub>hkl</sub> 是由于应变引起的半高峰宽变化, 可以表示为<sup>[29]</sup>

$$\xi_{hkl} = \sqrt{\xi_{hkl,m}^2 - \xi_{hkl,0}^2},$$
 (12)

式中,  $\xi_{hkl,m}$  是检测样品衍射峰的 (*hkl*) 面的半高 峰宽,  $\xi_{hkl,0}$  是标准 Ag 衍射峰的 (*hkl*) 面的半高峰 宽, 此处的标准 Ag 选取 99.99% 的电解纯 Ag 为参 照.本实验中利用分析软件分析样品 XRD 曲线的 (111) 和 (200) 衍射面的半高峰宽  $\xi_{hkl,m}$ , 结合 (12) 式计算了样品 (111) 和 (200) 衍射面因应变引起的 半高峰宽变化  $\xi_{hkl}$ .

根据 (10) 式—(12) 式计算出固溶-冷轧后 Ag-7wt.%Cu 合金的微观应变  $\varepsilon$  是 1.025 × 10<sup>-2</sup>, 位错 密度为 2.03 × 10<sup>16</sup>/m<sup>2</sup>, 450 °C 时效 2 h 后微观应 变  $\varepsilon$  是 4.62 × 10<sup>-3</sup>, 位错密度为 5.02 × 10<sup>15</sup>/m<sup>2</sup>, 由 此计算出固溶 - 冷轧 Ag-7wt.%Cu 合金的位错强化 为 241 MPa, 450 °C 时效 2 h 后位错强化作用为 120 MPa. 对于固溶-时效 Ag-7wt.%Cu 合金, 因为 没有变形, 所以位错密度很小, 位错强化作用很小, 所以不考虑位错引起的强化作用.

固溶-冷轧 Ag-7wt.%Cu 合金时效后的显微硬 度变化趋势与未变形合金的硬度变化明显不同.随 着时效温度的增加,固溶-冷轧合金的显微硬度一 直呈下降趋势(图6(b)),这是因为冷轧变形后合金 内部形成大量位错和形变孪晶,位错及孪晶对合金 强化作用非常显著.

|                          | SS-aged alloy                 |                                 |  |  |                              |                              |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Ageing<br>temperature/°C | $\mathrm{HV}_{0}/\mathrm{HV}$ | $\Delta \tau_{\rm SS}/{ m MPa}$ | $\Delta 	au_{\mathrm{P}}/\mathrm{MPa}$ | $\Delta 	au_{\mathrm{D}}/\mathrm{MPa}$ | $\Delta HV_{\rm T}/{\rm HV}$ | $\Delta HV_{\rm M}/{\rm HV}$ |  |  |  |
| No ageing                | 48                            | 158                             | _                                      | _                                      | 95.4                         | 95.3                         |  |  |  |
| 450                      | 48                            | 27                              | 231                                    | 231 —                                  |                              | 150                          |  |  |  |
|                          |                               | RS-aged alloy                   |  |  |                              |                              |  |  |  |
| No ageing                | 48                            | 89                              | _                                      | 241                                    | 147                          | 217                          |  |  |  |
| 450                      | 48                            | 20                              | 106                                    | 120                                    | 121                          | 105                          |  |  |  |

表 3 固溶-时效和固溶 -冷轧-时效 Ag-7wt.%Cu 合金各强度的计算值和测量值 Table 3. Calculated and measured strength in quench-aged and quench-rolled-aged Ag-7 wt.%Cu alloy.

注: 1 HV = 1 MPa×3/10; Δ*HV*<sub>T</sub>, total microhardness by calculation; Δ*HV*<sub>M</sub>, measured microhardness.

表3列出了各强化机制对Ag-7wt.%Cu合金显 微硬度的贡献.由表3可知,对于固溶Ag-7wt.%Cu 合金,固溶强化作用是主导因素.450°C时效2h 后,固溶强化作用降低,富Cu相的析出强化作用 占主导作用.结果中计算值与测量值趋势基本 符合;对于固溶-冷轧Ag-7wt.%Cu合金,冷轧后 显微硬度主要是位错强化作用,此处计算值远 小于测量值,是因为形变后Ag-7wt.%Cu合金中 产生大量形变孪晶,对显微硬度同样有贡献.固 溶-冷轧Ag-7wt.%Cu合金450°C时效后,一方面 由于富Cu相的析出强化作用,另一方面由于退 火孪晶的存在产生晶格应变,使得位错密度理 论计算值偏大,因此此处显微硬度计算值比测 量值大.

冷轧变形后,形成大量位错,位错密度急剧升高,并且形成大量Ag的孪晶,位错强化和孪晶强化二者同时作用,使合金硬度达到最大.200°C时效时,由于形变能的释放,位错胞开始逐渐释放,导致硬度略微降低.温度达到300°C时,硬度下降到160 HV,高于此温度下固溶合金的硬度值112 HV.在此温度下,富Cu相的弥散强化作用与位错的强化作用以及孪晶强化作用同时使合金保持较高的硬度.时效温度升高至450°C时,硬度下降到105 HV,低于此温度下固溶合金的硬度值150 HV,一方面这是因为位错的强化作用减弱,一方面是因为450°C时,孪晶尺寸显著增大,孪晶强化作用同时减弱,这两方面的作用导致硬度显著下降.进一步升高时效温度至500°C—760°C,富Cu相开始重新溶于Ag基体中,其弥散强化作用逐渐

减弱,导致合金的硬度显著降低.

#### 5 结 论

1) 固溶 Ag-7wt.%Cu 合金在时效过程中富 Cu 相由 Ag 基体中析出的温度为 300 °C—350 °C, 析 出激活能为(111 ± 1.6) kJ/mol; 而在固溶-冷轧 Ag-7wt.%Cu 合金中,由于形变能的存在,富 Cu 相的析出温度为 290 °C—330 °C, 析出激活能为 (128 ± 12) kJ/mol.

2) 对于固溶 Ag-7wt.%Cu 合金,随着时效温度 的增加,固溶合金中富 Cu 相逐渐析出,降低了合金 的电阻率,同时富 Cu 相的析出强化作用使得显微 硬度升高,在时效温度为450°C,富 Cu 相的析出致 使硬度达到最大值.

3) 对于固溶-冷轧 Ag-7wt.%Cu 合金, 富 Cu 相的析出行为是影响电阻率的主要因素, 而位错和形变孪晶是影响显微硬度的主要因素.

感谢美国国家强磁场实验室 Han Ke博士在此论文书 写和讨论中给予的有益建议,感谢美国国家强磁场实验室 Niu Rongmei博士对英文摘要的校对.

#### 参考文献

- Northover S M, Northover J P 2014 Mater. Charact. 90 173
- [2] Wanhill RJ H 2005 Anal. Prev. 5 41
- [3] Embury J D, Han K 1998 Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 3 304
- [4] Lussana D, Castellero A, Vedani M, Ripamonti D, Angella G, Baricco M 2014 J. Alloys Compd. 615 S633

- [5] Subramanian P, Perepezko J 1993 J. Phase Equilib. 14
   62
- [6] Wiest P Z 1933 Metallkd. **25** 238
- [7] Hamana D, Boumaza L 2009 J. Alloys Compd. 477 217
- [8] Gayler M, Carrington W 1947 Acta Mater. 73 625
- [9] Butrymowicz D B, Manning J R, Read M E 1974 J. Phys. Chem. Ref. Data 3 527
- [10] Jones F, Leech P, Sykes C 1942 Proc. R. Soc. London Ser. A 181 154
- [11] Youssef S 1996 Physica B **228** 337
- [12] Nada R 2004 Physica B 349 166
- [13] Wang C J, Ning Y T, Zhang K H, Geng Y H, Bi J, Zhang J M 2009 Mater. Sci. Eng. A 517 219
- [14] Kissinger H E 1957 Anal. Chem. 29 1702
- [15] Zuo X W, Zhao C C, Zhang L, Wang E G 2016 *Mater*.
   9 569
- [16] Zhao C C, Zuo X W, Wang E G, Niu R M, Han K 2016 Mater. Sci. Eng. A 652 296
- [17] Kurz W, Trivedi R 1996 Metall. Mater. Trans. A 27 625
- [18] Northover P, Northover S, Wilson A 2013 Met. Sci. 2 253
- [19] Colombo S, Battaini P, Airoldi G 2007 J. Alloys Compd.
   437 107

- [20] Gaganov A, Freudenberger J, Botcharova E, Schultz L 2006 Mater. Sci. Eng. A 437 313
- [21] Smith D R, Fickett F 1995 J. Res. Nat. Inst. Stand. Technol. 100 119
- [22] Zuo X W, Guo R, An B L, Zhang L, Wang E G 2016 Acta Metall. Sin. 65 143 (in Chinese) [左小伟, 郭睿, 安 佰灵, 张林, 王恩刚 2016 金属学报 65 143]
- [23] Mohamed I F, Yonenaga Y, Lee S, Edalati K, Horita Z 2015 Mater. Sci. Eng. A 627 111
- [24] Frye J H, Hume-Rothery W 1942 Proc. R. Soc. London Ser. A 8 1
- [25] Freudenberger J, Lyubimova J, Gaganov A, Witte H, Hickman A L, Jones H 2010 Mater. Sci. Eng. A 527 2004
- [26] Pugh S 1954 Philos. Mag. 45 823
- [27] Gottstein G 2007 Physikalische Grundlagen der Materialkunde (3rd Ed.) (New York: Springer-Verlag) p271
- [28] Hull D, Bacon D J 1989 Introduction to Dislocations (2nd Ed.) (Oxford: Pergamon Press) p243
- [29] Williamson G, Smallman R 1956 Philos. Mag. 1 34

# Microstructure, resistivity, and hardness of aged Ag-7wt.%Cu alloy\*

Li Rui<sup>1)2)</sup> Zuo Xiao-Wei<sup>1)3)</sup> Wang En-Gang<sup>1)3)†</sup>

1) (Key Laboratory of Electromagnetic Processing of Materials (Ministry of Education), Northeastern University, Shenyang 110819, China)

2) (School of Materials Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang 110819, China)

3) (School of Metallurgy, Northeastern University, Shenyang 110819, China)( Received 19 September 2016; revised manuscript received 16 October 2016 )

#### Abstract

Ag-Cu alloys are used as both decorative materials because of beautiful appearance, and conductors due to excellent combinations of strength and electrical conductivity. The strength and electrical conductivity of Ag-Cu alloy are closely related to precipitation behavior of Cu-rich phase in Ag matrix. The morphology, size and volume fraction of Curich phase have been highly concerned. In this work, a series of aging temperatures is used in both supersaturated solid-solution and cold-rolled Ag-7wt.%Cu samples to investigate the relationship between the precipitation behavior of Cu-rich phase and property by using differential scanning calorimetry (DSC), transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD) analysis, and properties measurements (hardness and resistivity). The DSC results of as-solidsolution Ag-7wt.%Cu alloy show a distinct exothermic precipitation reaction of Cu out of Ag matrix ranging from 300 °C to 350 °C, and the activation energy is estimated to be  $(111 \pm 1.6)$  kJ/mol according to Kissinger equation. Because of the existence of deformation energy, the DSC results of cold-rolled Ag-7wt.%Cu sample show a distinct exothermic precipitation reaction of Cu from Ag matrix between 290  $^{\circ}$ C and 330  $^{\circ}$ C, and the activation energy is (128±12) kJ/mol. XRD analysis indicates that the dissolved Cu in Ag is dependent on ageing temperature, and the change of solubility of Cu in Ag is calculated by XRD curve. Microstructural analysis demonstrates that spherical Cu-rich phases are precipitated from Ag-matrix at 450 °C in both solid-solution and cold-rolled Ag-7wt.%Cu alloys. Moreover, the banded structure of Cu-rich phase is found in the solid-solution sample after being aged at 450 °C. The deformation twinning Ag is found in the cold-rolled sample. The precipitation and dissolution of Cu-rich phase in Ag matrix play important roles in the resistivity and microhardness. With ageing temperature increasing (ageing temperatures range from 200 to 450 °C), the electrical resistivity of as-solid-solution aged sample decreases and the microhardness increases, however, both electrical resistivity and microhardness of as-cold-rolled aged sample decrease. With ageing temperature increasing further (over 450  $^{\circ}$ C), the electrical resistivity increases and the microhardness decreases in both aged samples. Because of the formations of dislocation and deformation twinning Ag, the microhardness of cold-rolled sample reaches to 217 HV, which is higher than that of solid-solution sample. Strengthening and electrical resistivity models are built based on the microstructural characterization and concentration contributions. These theoretical predictions are in good agreement with experimental values. Our model demonstrates that the precipitation and dissloution of Cu in Ag significantly affect the electrical conductivity, and dislocation and deformation twinning play important roles in microhardess in Ag-Cu alloy. This work clarifies the influencing mechanism of different microstructures on the microhardness and resistivity of Ag-Cu alloy.

Keywords: Ag-Cu alloy, microstructure, resistivity, microhardness

**PACS:** 74.25.–q, 81.05.–t

**DOI:** 10.7498/aps.66.027401

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 51474066, 51004038) and the Program of Introducing Talents of Discipline to Universities, China (Grant No. B07015).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: egwang@mail.neu.edu.cn